

エレクトロニクスソサイエティ
材料デバイスサマーミーティングのお知らせ

エレクトロニクスソサイエティ (ES) では 6 月 19 日 (金), 機械振興会館において材料デバイスサマーミーティングを開催します。これは, 以前から続けてまいりました「材料・デバイス連合講演会」を発展させたものです。材料・デバイス分野の研究者が一堂に会して有益な意見交換ができる場を提供することが目的の一つです。

今年度も, 昨年度と同様に, 7 つの研究会が参加します。(5 つの第一種研究会に加えて, 集積光デバイスと応用技術時限研究会, 次世代ナノ技術時限研究会が参加します。)

また, 東京大学荒川泰彦氏による国際光年 (IYL2015) 特別講演「光電子融合によるフォトンクスイノベーションに向けて」の開催 (地下 3 階研修 1 号室, 11:00~12:00) を予定しております。

多数の方に参加して頂けるよう以下に御案内申し上げます。

★機構デバイス研究会 (EMD)

専門委員長 関川純哉 副委員長 阿部宜輝
幹事 澤田 滋・鈴木健司 幹事補佐 和田真一

★電子部品・材料研究会 (CPM)

専門委員長 野毛 悟 副委員長 廣瀬文彦
幹事 小館淳一・岩田展幸 幹事補佐 坂本 尊・中村雄一

★有機エレクトロニクス研究会 (OME)

専門委員長 松田直樹 副委員長 森 竜雄
幹事 鴻野晃洋・染谷隆夫 幹事補佐 梶井博武・田口 大

★光エレクトロニクス研究会 (OPE)

専門委員長 植之原裕行 副委員長 小川憲介
幹事 中川剛二・鈴木賢哉 幹事補佐 石樽崇明・柳生栄治

★レーザ・量子エレクトロニクス研究会 (LQE)

専門委員長 小路 元 副委員長 野田 進
幹事 梅沢俊匡・藤原直樹

日時 6 月 19 日 (金) 9:50~17:35

会場 機械振興会館地下 3 階研修 1 号室, 研修 2 号室 (港区芝公園 3-5-8. 東京メトロ日比谷線: 神谷町駅下車徒歩 10 分, JR: 浜松町駅下車徒歩 20 分, 都営地下鉄三田線: 御成門駅・大江戸線: 赤羽橋駅下車徒歩 10 分. http://www.jcmanet.or.jp/gaiyo/map_kaikan.htm TEL (03) 3434-8211)

議題 材料デバイスサマーミーティング

1. [国際光年 (IYL2015) 特別講演] 光電子融合によるフォトンクスイノベーションに向けて 荒川泰彦 (東大)
午後 セッション 1 (地下 3 階研修 2 号室 13:00~17:35) (機構デバイス/電子部品・材料/有機エレクトロニクス)
1. YAlO₃(001) 基板表面処理条件の違いによる Cr₂O₃ 薄膜の結晶成長
○橋本浩佑・隅田貴士・林 佑太郎・福井慎二郎・永田知子・山本 寛・岩田展幸 (日大)
2. ペッチーニ法による Bi 過剰 BiFeO_x ターゲットの作製及び BiFeO₃ 薄膜の作製
○王 春・大島佳祐・稲葉隆哲・宋 華平・渡部雄太・永田知子・橋本拓也・高瀬浩一・山本 寛・岩田展幸 (日大)
3. 化学気相成長法を用いて作製した単層グラフェンの積層による 2 層グラフェンの作製と電気特性
○星野 峻・林 佑太郎・今井健太郎・鈴木 希・永田知子・山本 寛・岩田展幸 (日大)
4. 大気圧 CVD 法による酸化スズ及び酸化ガリウムナノワイヤーの成長
○寺迫智昭 (愛媛大)・矢木正和 (香川高専)
5. 触媒反応支援 CVD 法によるガラス基板上 ZnO 膜成長における N₂O 添加初期層の効果
○叶内慎吾・石塚脩己・大橋優樹 (長岡技科大)・大石耕一郎・片桐裕則 (長岡高専)・玉山泰宏・安井寛治 (長岡技科大)
6. 触媒反応生成高エネルギー H₂O ビームのノズル開口角依存性
寺口祐介・田島諒一・中村友紀・高橋一匡・玉山泰宏・○安井寛治 (長岡技科大)

7. 統計的手法を用いた微摺動機構による電気接点劣化現象解析—いくつかの実験条件下における最小摺動振幅データを用いた統計解析— ○越田圭治・和田真一・久保田洋彰（TMC システム）・澤 孝一郎（日本工大）
 8. 金属ガラス薄帯へのアルミニウム薄板の電磁圧接
○相沢友勝（都立工業高専）・松澤和夫（都立産技高専）・網谷健児（東北大）
 9. 異なる電極開離速度における AgSnO₂ 接点对による直流負荷電流遮断時のアーク放電特性に関する実験的検討
長谷川 誠（千歳科技大）
 10. 電界誘起光第 2 次高調波発生法による有機材料中の 3 次元電界評価 ○間中孝彰・岩本光正（東工大）
- セッション 2（地下 3 階研修 1 号室 9：50～16：45）（光エレクトロニクス／レーザ・量子エレクトロニクス）

アクティブデバイスと集積化技術，一般

1. PLZT 導波路を用いた光通信用波長選択素子
○浅倉秀明（慶大）・梨本恵一（エピフォトニクス）・津田裕之（慶大）
 2. 3 次元 SiO_{xx} 導波路プラットフォーム上ファイバモード合分波器
○開 達郎・土澤 泰・西 英隆・山本 剛（NTT）
 3. 〔国際光年（IYL2015）特別講演〕 光電子融合によるフォトリソノボーションに向けて 荒川泰彦（東大）
- 午後
4. 1550 nm 帯多重積層 QD 構造の光集積素子に向けた Ar イオン注入を用いた QD Intermixing
○松本 敦（NICT）・武井勇樹（早大）・赤羽浩一（NICT）・松島裕一・宇高勝之（早大）・山本直克・川西哲也（NICT）
 5. 直接貼付 InP 層を用いた異種基板上 III-V 族半導体発光デバイスの集積
○松本恵一・金谷佳則・岸川純也・下村和彦（上智大）
 6. チャープ制御したフェムト秒パルス励起による GaP 結晶からの THz 波発生
○浜崎淳一・関根徳彦・笠松章史・寶迫 巖（NICT）
 7. 〔招待講演〕 次世代光アクセスネットワークのための波長可変光源 小山二三夫（東工大）
 8. 次世代コヒーレント伝送向け DFB アレイ集積型波長可変レーザ
○黒部立郎・木村俊雄・越 浩之・向原智一（古河電工）
 9. スポットサイズ変換器集積 GaAs 基板上量子ドットレーザ
○植竹理人・高林和雅・木村徳治・山本剛之（富士通研）・山口正臣・高田 幹・武政敬三・菅原 充（QD レーザ）・荒川泰彦（東大）
 10. 次世代 100GbE 対応小型トランシーバ向け 1.3 μm 帯 25.8 Gbps 直接変調 DFB レーザの 85℃ エラーフリー 10 km ファイバ伝送
○中島崇之・深町俊彦・明石光央・中村 厚・佐久間 康・早川茂則・鷺野 隆・向久保 優・岡本 薫・元田勝也・直江和彦・中原宏治・田中滋久・魚見和久（日本オクラロ）
 11. APD の高線形化と 28Gbaud PAM4 動作への応用
○名田允洋・星 拓也・山崎裕史・横山春喜・橋本俊和・松崎秀昭（NTT）

☆EMD 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

7 月 10 日（金） 機械振興会館〔締切済〕 テーマ：放電，実装，EMC 一般

【問合先】

関川純哉（静岡大）

TEL & FAX [053] 478-1618

E-mail: tjsekik@ipc.shizuoka.ac.jp

久我宣裕（横浜国大）

TEL & FAX [045] 339-4279

E-mail: kuga@ynu.ac.jp

服部康弘（住友電装）

TEL [059] 382-8634, FAX [059] 382-8591

E-mail: yasuihiro-hattori@gate.sws.co.jp

阿部宜輝（NTT デバイスイノベーションセンタ）

TEL [046] 240-2262, FAX [046] 270-6421

E-mail: abe.yoshiteru@lab.ntt.co.jp

◎EMD 研究会に関する最新の情報は，<http://www.ieice.org/es/emd/jpn/> を御参照下さい。

☆OME 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

7 月 29 日（水） 富山大工学部〔締切済〕 テーマ：有機薄膜，有機デバイス，一般

【問合先】

森 竜雄（愛知工大）

E-mail : t2mori@aitech.ac.jp

瀧本 清 (キヤノン電子)

E-mail : takimoto.kiyoshi@canon-elec.co.jp

☆OPE 研究会今後の予定 [] 内発表申込締切日

7月16日(木), 17日(金) 釧路市生涯学習センター〔締切済〕 テーマ: 光・電波ワークショップ

【問合先】

荒川太郎 (横浜国大)

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5

TEL [045] 339-4143, FAX [045] 338-1157

E-mail : arakawa@ynu.ac.jp

中川剛二 (富士通研)

〒211-8588 川崎市中原区上小田中 4-1-1

TEL [044] 754-2643, FAX [044] 754-2640

E-mail : gnakagawa@jp.fujitsu.com

鈴木賢哉 (NTT デバイスイノベーションセンタ)

〒243-0198 厚木市森の里若宮 3-1

TEL [046] 240-4084, FAX [046] 240-4526

E-mail : s.kenya@lab.ntt.co.jp

◎OPE 研究会ホームページ

<http://www.ieice.or.jp/es/ope/>

◎OPE 研究会では, H18 年度より「学生優秀研究賞」を新設しました. 学生の方の発表の中から特に優れた研究を表彰致しますので, 積極的な御投稿をお待ちしています. 詳細は研究会 HP を御覧下さい.

☆LQE 研究会

【問合先】

梅沢俊匡 (NICT)

TEL [042] 327-7528, FAX [042] 327-7938

E-mail : toshi_umezawa@nict.go.jp

藤原直樹 (NTT 集積デバイス研究所)

TEL [046] 240-3266, FAX [046] 240-4345

E-mail : fujiwara.naoki@lab.ntt.co.jp

◎LQE 研究会ホームページ

<http://www.ieice.org/~lqe/jpn/>

◎LQE 研究会では平成 18 年度より「LQE 奨励賞」を設けました. 対象は発表年度の 4 月 1 日時点で 32 歳以下の若手研究者 (学生を含む) です. 積極的に御投稿下さい.